

关键指标

频率: 0.96~1.25GHz
 功率增益: 32dB
 3dB 压缩点输出功率: 41dBm
 3dB 压缩点漏极效率: 45%
 二次/三次谐波: -35dBc
 工作电压: Vdd: +28V, Vgg: -2.4V
 芯片尺寸: 22mm×19mm×5.5mm

产品简介

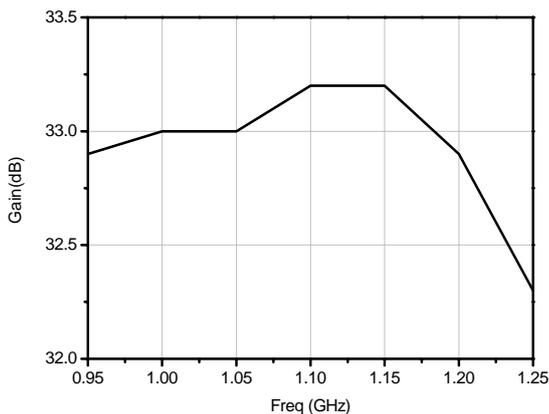
HG532FA-F08 是一款 0.96~1.25GHz 内匹配功放管, 采用 GaN HEMT 工艺制作, 功率增益为 32dB, 3dB 压缩点输出功率为 41dBm, 3dB 压缩点漏极效率为 45%。

电性能 (T_A=25°C, Vdd=+28V, 连续波测试)

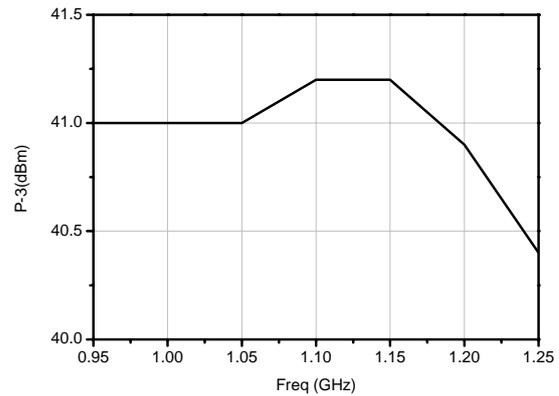
指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	0.96~1.25		
功率增益(dB)	—	32	—
增益平坦度(dB)	—	±0.5	—
输入驻波	—	2	—
输出驻波	—	2	—
3dB 压缩点输出功率(dBm)	—	41	—
3dB 压缩点漏极效率 (%)	—	45	—
二次/三次谐波 (dBc)	—	-35	—

典型测试曲线

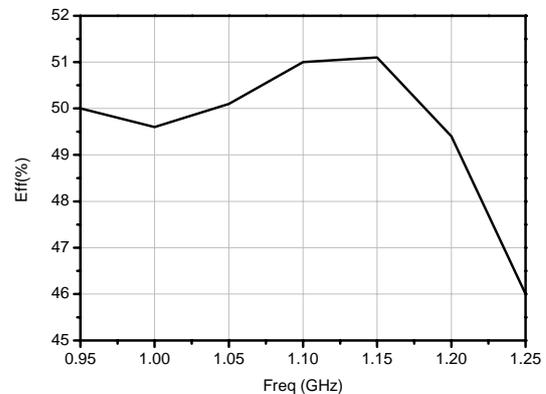
功率增益



3dB 压缩点输出功率



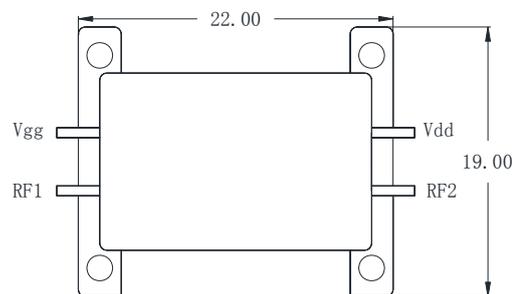
3dB 压缩点漏极效率



绝对额定最大值

工作电压	36V
最大输入功率	+15dBm
工作温度	-55°C~85°C
存储温度	-65°C~150°C

外形和端口尺寸 (mm) (管壳: BF04)



注意事项

1. 功放管在干燥、氮气环境中存储, 在超净环境使用;
2. 功放管管脚硬度低, 外力扭曲容易断裂, 使用时必须小心;
3. 功放管栅极、漏极馈电线需焊接 10uF 去耦电容, 去耦电容耐压值 ≥ 50V;
4. 功放管对静电敏感, 在储存和使用过程中注意防静电。